

2Т3160А-2
кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
п-р-п транзистор

Назначение

Кремниевый эпитаксиально-планарный импульсный бескорпусный п-р-п транзистор 2Т3160А-2 предназначен для применения в составе специальных гибридных интегральных микросхем, блоков и аппаратуры.

Обозначение технических условий

- аАО.339.591 ТУ

Корпусное исполнение

- бескорпусное исполнение

Диапазон температур

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °С

Таблица 1. Основные электрические параметры 2Т3160А-2 при $T_{\text{окр. среды}} = (25 \pm 10) \text{ } ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА, при $U_{\text{КБ}} = 50 \text{ В}$	$I_{\text{КБО}}$	-	10
Обратный ток эмиттера, мкА, при $U_{\text{ЭБ}} = 4 \text{ В}$	$I_{\text{ЭБО}}$	-	50
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, при $U_{\text{КЭ}} = 3 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 150 \text{ мА}$, $\tau_n \leq 30 \text{ мкс}$, $Q \geq 50$	$h_{21Э}$	30	150
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером, МГц, при $U_{\text{КЭ}} = 10 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 50 \text{ мА}$, $f = 10^8 \text{ Гц}$	$f_{\text{гр}}$	200	-
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при $I_{\text{К}} = 150 \text{ мА}$, $I_{\text{Б}} = 15 \text{ мА}$, $\tau_n \leq 30 \text{ мкс}$, $Q \geq 50$	$U_{\text{КЭ нас}}$	-	0,6
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при $I_{\text{К}} = 150 \text{ мА}$, $I_{\text{Б}} = 15 \text{ мА}$, $\tau_n \leq 30 \text{ мкс}$, $Q \geq 50$	$U_{\text{БЭ нас}}$	-	1,2
Граничное напряжение, В, при $I_{\text{Б}} = 0$, $I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$, $\tau_n \leq 30 \text{ мкс}$, $Q \geq 50$	$U_{\text{КЭогр}}$	36	-
Емкость коллекторного перехода, пФ, при $U_{\text{КБ}} = 10 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 0$, $f = 10^7 \text{ Гц}$	$C_{\text{К}}$	-	5
Емкость эмиттерного перехода, пФ, при $U_{\text{ЭБ}} = 0$, $I_{\text{К}} = 0$, $f = 10^7 \text{ Гц}$	$C_{\text{Э}}$	-	30
Время рассасывания, нс, при $I_{\text{К}} = 150 \text{ мА}$, $I_{\text{Б1}} = I_{\text{Б2}} = 15 \text{ мА}$, $\tau_n \leq 30 \text{ мкс}$, $Q \geq 50$	$t_{\text{рас}}$	-	100

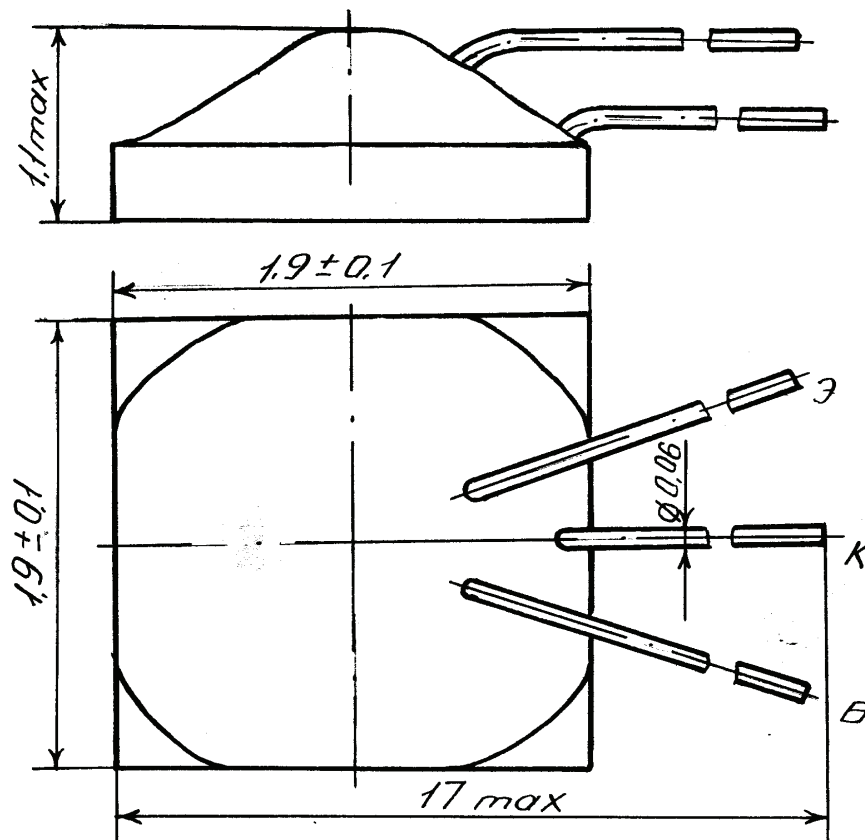


Рисунок 1. Габаритный чертеж 2ТЗ160А-2



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>